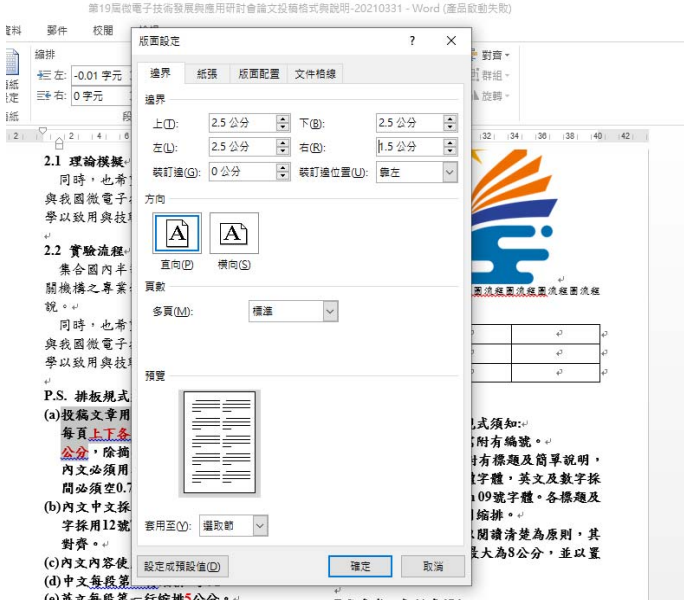
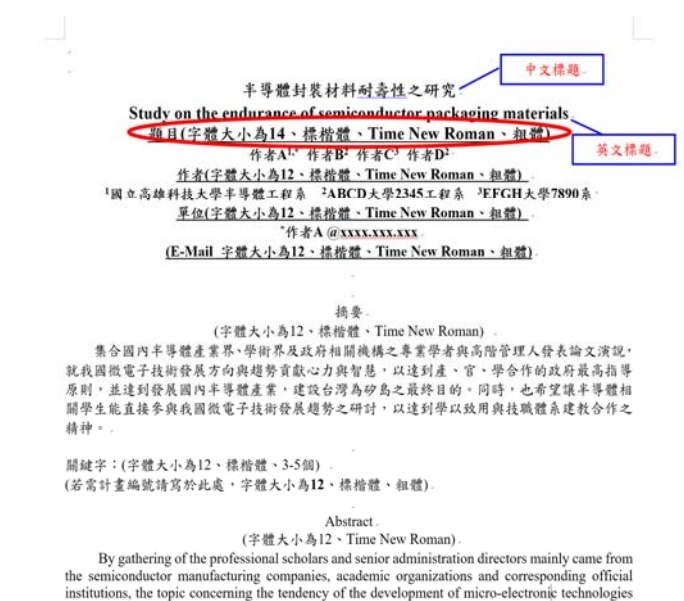


# 2022 第二十屆微電子技術發展與應用研討會全文說明

一	<p>投稿信件<b>主旨</b></p> <p>檔名為組別_論文編號_題目。</p>
二	<p>摘要、論文投稿檔名</p> <p>以“組別_論文編號_題目”</p> <p>如：<b>訊號與系統組_A1_具全景○○辨識輔助系統</b></p>
三	<p>摘要、論文投稿檔案</p> <p>稿件一律以 WORD 及 PDF 檔，並於研討會網頁“全文上傳”區上傳</p>
四	<p>投稿文章用 A4(210mm*297mm)的紙張，<b>邊界每頁上下各空 2.5 公分，左 2.5 公分，右空 1.5 公分</b></p>  <p>第19屆微電子技術發展與應用研討會論文投稿格式與說明-20210331 - Word (產品啟動失敗)</p> <p>2.1 理論模擬 同時，也希望我國微電子學以致用與技</p> <p>2.2 實驗流程 集國內半導體機構之專業現。 同時，也希望我國微電子學以致用與技</p> <p>P.S. 排版格式 (a)投稿文章用每頁上下各<b>公分</b>，除摘要內文必須用開必須空0.7 (b)內文中文採字採用12號對齊。 (c)內文內容使 (d)中文每段第 (e)英文每段第一行縮排5公分。</p> <p>格式須知： 附有編號。 附有標題及簡章說明， 字體、英文及數字採 109號字體。各標題及 縮排。 閱讀清楚為原則，其 最大為8公分，並以置</p>
五	<p>第一行--<b>中文</b>標題： 『字型：標楷體、字體大小 14、粗體、置中。』</p> <p>第二行--<b>英文</b>標題： 『字型：Time New Roman、字體大小 14、粗體、置中。』</p>  <p>半導體封裝材料耐毒性之研究 <b>Study on the endurance of semiconductor packaging materials</b> <b>題目(字體大小為14、標楷體、Time New Roman、粗體)</b></p> <p>作者A<sup>1</sup> 作者B<sup>2</sup> 作者C<sup>3</sup> 作者D<sup>4</sup> 作者(字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體) <sup>1</sup>國立高雄科技大學半導體工程系 <sup>2</sup>ABCD大學2345工程系 <sup>3</sup>EFGH大學7890系 單位(字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體) <sup>4</sup>作者A @xxxx.xxx.xxx (E-Mail 字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體)</p> <p>摘要 (字體大小為12、標楷體、Time New Roman) 集國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說，就我國微電子技術發展方向與趨勢貢獻心力與智慧，以達到產、官、學合作的政府最高指導原則，並達到發展國內半導體產業，建設台灣為矽島之最終目的。同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。</p> <p>關鍵字：(字體大小為12、標楷體、3-5個) (若需計畫編號請寫於此處，字體大小為12、標楷體、粗體)</p> <p>Abstract (字體大小為12、Time New Roman) By gathering of the professional scholars and senior administration directors mainly came from the semiconductor manufacturing companies, academic organizations and corresponding official institutions, the topic concerning the tendency of the development of micro-electronic technologies</p>

- 六
- 第三行--作者：『字型：標楷體(英文及數字為Time New Roman)、字體大小12、粗體、置中。』
  - 第四行--作者單位：『字型：標楷體(英文及數字為Time New Roman)、字體大小12、粗體、置中。』
  - 多人作者時註記應與作者之單位相對應(右圖紅、黃及紫圈處)。
  - 若作者皆為同單位則須標記同數字。
  - 通訊作者標記須於數字標記後方多加「,\*」
  - 若通訊作者為多位，須按照作者順序排序。

半導體封裝材料耐毒性之研究  
 endurance of semiconductor packaging materials  
 作者A<sup>1</sup> 作者B<sup>2</sup> 作者C<sup>3</sup> 作者D<sup>4</sup>  
 作者(字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體)  
 1. 國立高雄科技大學半導體工程系 2. ABCD大學2345工程系 3. FGH大學7890系  
 單位(字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體)  
 通訊作者Email, 左上角需註記\*  
 \*作者A @XXXX.XXX.XXX  
 字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體

摘要  
 (字體大小為12、標楷體、Time New Roman)  
 集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說，就我國微電子技術發展方向與趨勢貢獻心力與智慧，以達到產、官、學合作的政府最高指導原則，並達到發展國內半導體產業，建設台灣為矽島之最終目的。同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

關鍵字：(字體大小為12、標楷體、3-5個)  
 (若需計畫編號請寫於此處，字體大小為12、標楷體、粗體)

Abstract  
 (字體大小為12、Time New Roman)  
 By authoring of the professional scholars and senior administration directors mainly come from

七 第一頁行距皆為單行間距。

19屆微電子技術發展與應用研討會論文投稿格式與說明-20210331 - Word (產品啟動失敗)

縮排與行距 (L) 分行與分頁設定 (P) 中文印刷樣式 (H)

一般  
 對齊方式 (G): 置中對齊  
 大綱階層 (O): 本文

縮排  
 左 (L): 0 字元  
 右 (R): 0 字元  
 指定方式 (S): 位移點數 (O)  
 繪像縮排 (M)  
 文件格線被設定時，自動調整右側縮排 (D)

段落間距  
 與前段距離 (B): 0 行  
 與後段距離 (E): 0 行  
 行距 (N):  
 行高 (A):  
 相同樣式的各段落之間不要加上間距 (C)  
 文件格線被設定時，貼齊格線 (V)

摘要  
 Study on the endurance of semiconductor packaging materials

定位點 (T) 設定成預設值 (D) 確定 取消

- 八
- 中、英文摘要放置第1頁(共1頁為限)，內文放置第2頁之後。
  - 中文摘要：『字型：標楷體(英文及數字為Time New Roman)、字體大小12、左右對齊，第一行縮排二字元。』
  - 中文關鍵字：『字型：標楷體(英文及數字為Time New Roman)、字體大小12、靠左對齊。』
  - 英文摘要：

半導體封裝材料耐毒性之研究  
 Study on the endurance of semiconductor packaging materials  
 題目(字體大小為14、標楷體、Time New Roman、粗體)  
 作者A<sup>1</sup> 作者B<sup>2</sup> 作者C<sup>3</sup> 作者D<sup>4</sup>  
 作者(字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體)  
 國立高雄科技大學半導體工程系 ABCD大學2345工程系 FGH大學7890系  
 單位(字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體)  
 作者A @XXXX.XXX.XXX 作者B @XXXX.XXX.XXX 作者C @XXXX.XXX.XXX 作者D @XXXX.XXX.XXX  
 (E-Mail 字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體)

摘要  
 (字體大小為12、標楷體、Time New Roman)  
 集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說，就我國微電子技術發展方向與趨勢貢獻心力與智慧，以達到產、官、學合作的政府最高指導原則，並達到發展國內半導體產業，建設台灣為矽島之最終目的。同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

關鍵字：(字體大小為12、標楷體、3-5個)  
 (若需計畫編號請寫於此處，字體大小為12、標楷體、粗體)

Abstract  
 (字體大小為12、Time New Roman)  
 By gathering of the professional scholars and senior administration directors mainly come from the semiconductor manufacturing companies, academic organizations and corresponding official institutions, the topic concerning the tendency of the development of micro-electronic technologies is thoughtfully presented and well discussed. Through the view-points form their elaborate contributions to the micro-electronics, Taiwan as the Silicon Island the government policy, could be ultimately fulfilled. Also, providing direct presentations and dialogues about the development of the micro-electronic technologies in this conference for the students who take interest in the academic field of semiconductor, is to implement the goal of making study serve the practical purpose in the technical and vocational education system.

Keywords: (字體大小為12、Time New Roman、3-5-words)  
 (若需計畫編號請寫於此處，字體大小為12、Time New Roman、粗體)

P.S.  
 中、英文摘要放置第1頁(共1頁為限)、內文放置第2頁之後。

『字型：Time New Roman、字體大小12、左右對齊，縮排一公分。』

■ 英文關鍵字：

『字型：Time New Roman、字體大小12、靠左對齊。』

九 ■ 撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。

■ 內文：

『中文字型：標楷體(英文及數字為Time New Roman)、字體大小12、左右對齊。』

1. 前言  
聯合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與投職體系建教合作之精神。

2. 原理  
聯合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與投職體系建教合作之精神。

2.1 理論模擬  
同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與投職體系建教合作之精神。

2.2 實驗流程  
聯合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與投職體系建教合作之精神。

P.S. 排版格式須知：  
(a) 投稿文章用A4(210mm\*297mm)的紙張，每頁上下各空2.5公分，左2.5公分，右空1.5公分，除摘要使用單欄的編排格式，撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。  
(b) 內文中文採用12號標楷體字體，英文及數字採用12號Times New Roman字體，左右對齊。

(c) 標題及字體應靠右對齊，單行標題，前後段距離1行，每行標題前加一行空行。  
(d) 所有公式及方程式均應打寫或音寫清楚，或應標於圓括弧內並置於其後。

(e) 所有圖表及照片必需附有編號。  
(f) 各圖表及照片必需附有標題及簡單說明，中文採用09號標楷體字體，英文及數字採用Times New Roman 09號字體。各標題及說明左右對齊，不用縮排。  
(g) 各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其大小之決定為橫寬最大為8公分，並以置中排版。

十 ■ 內文內容使用單行間距，前後段距離0行。

■ 中文每段第一行縮排1字元。

■ 英文每段第一行縮排5公分。

關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與投職體系建教合作之精神。

2. 原理  
聯合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與投職體系建教合作之精神。

2.1 理論模擬  
同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與投職體系建教合作之精神。

2.2 實驗流程  
聯合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與投職體系建教合作之精神。

P.S. 排版格式須知：  
(a) 投稿文章用A4(210mm\*297mm)的紙張，每頁上下各空2.5公分，左2.5公分，右空1.5公分，除摘要使用單欄的編排格式，撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。  
(b) 內文中文採用12號標楷體字體，英文及數字採用12號Times New Roman字體，左右對齊。

(j) 所有公式及方程式均應打寫或音寫清楚，或應標於圓括弧內並置於其後。

內文內容使用單行間距，前後段距離0行。

中文每段第一行縮排1字元。  
英文每段第一行縮排5公分。



- 標題與順序為1、2...等等以此類推。
- 子標題順序為2.1、2.2，本研討會規定至第二層止。
- 第一層標題(如1.前言)：『字型：標楷體、字體大小12、左右對齊。』
- 第二層含以下之子標題(如2.1 理論模擬、2.2 實驗流程)：『字型：標楷體、字體大小12、左右對齊。』

1. 前言  
 集會國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

2. 原理  
 集會國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

2.1 理論模擬  
 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

2.2 實驗流程  
 集會國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

P.S. 排版規式須知：  
 (a)投稿文章用A4(210mm\*297mm)的紙張，每頁上下各空2.5公分，左2.5公分，右空1.5公分，除摘要使用單欄的編排格式，撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。  
 (b)內文中文採用12號標楷體字體，英文及數字採用12號Times New Roman字體，左右對齊。

(h)第一層標題(如1.前言)使用粗體字型，字體為12號，第二層含以下之標題(如2.1 內文)使用粗體字型，字體為12號。  
 (i)標題及子標題靠左對齊，單行間距，前後段距離0行，但每節標題前加一行空行。  
 (j)所有公式及方程式均需用打字或書寫清楚，式號應標於圓括弧內並置於其後。

$$\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v = -\nabla p + \Delta v + f(x,t) \quad (1)$$

標題與子標題需使用粗體，標題順序為1、2、...等等。  
 第一層標題(如1.前言)使用粗體字型，字體為12號。

子標題順序為1.1、2.1、...等等，本研討會規定至第二層止。  
 第二層含以下之標題(如2.1 內文)使用粗體字型，字體為12號。

(b)各圖表及照片必需附有標題及簡單說明，中文採用09號標楷體字體，英文及數字採用Times New Roman 09號字體，各標題及說明左右對齊，不用縮排。  
 (c)各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其

- 標題及子標題使用單行間距，前後段距離0行，但每節標題與子標題前需空一行。
- 所有公式及方程式均需打字或書寫清楚，式號應標於圓括弧內並置於其後，若有多個公式及方程式，則需照順序排列(如圖黃圈處)。

1. 前言  
 集會國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

2. 原理  
 集會國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

2.1 理論模擬  
 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

2.2 實驗流程  
 集會國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

P.S. 排版規式須知：  
 (a)投稿文章用A4(210mm\*297mm)的紙張，每頁上下各空2.5公分，左2.5公分，右空1.5公分，除摘要使用單欄的編排格式，撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。  
 (b)內文中文採用12號標楷體字體，英文及數字採用12號Times New Roman字體，左右對齊。

(h)第一層標題(如1.前言)使用粗體字型，字體為12號，第二層含以下之標題(如2.1 內文)使用粗體字型，字體為12號。  
 (i)標題及子標題靠左對齊，單行間距，前後段距離0行，但每節標題前加一行空行。  
 (j)所有公式及方程式均需用打字或書寫清楚，式號應標於圓括弧內並置於其後。

$$\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v = -\nabla p + \Delta v + f(x,t) \quad (1)$$

所有公式及方程式均需用打字或書寫清楚，式號應標於圓括弧內並置於其後。

標題及子標題靠左對齊，單行間距，前後段距離0行，但每節標題前加一行空行。

P.S. 圖表及照片排版規式須知：  
 (a)所有圖表及照片必需附有編號。  
 (b)各圖表及照片必需附有標題及簡單說明，中文採用09號標楷體字體，英文及數字採用Times New Roman 09號字體，各標題及說明左右對齊，不用縮排。  
 (c)各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其

- 各圖表及照片必需附有標題及簡單說明(如表1、表2以及圖1、圖2以此類推)。
- 中文說明：『字型：標楷體、字體大小09、左右對齊，不用縮排。』(右圖黃框處)
- 英文及數字說明：『字型：Time New Roman、字體大小09、左右對齊，不用縮排。』(右圖黃框處)
- 各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其橫寬最大為8公分，並以置中排版。

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

學以致用與技職體系建教合作之精神。

2. 原理  
 集會國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

2.1 理論模擬  
 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

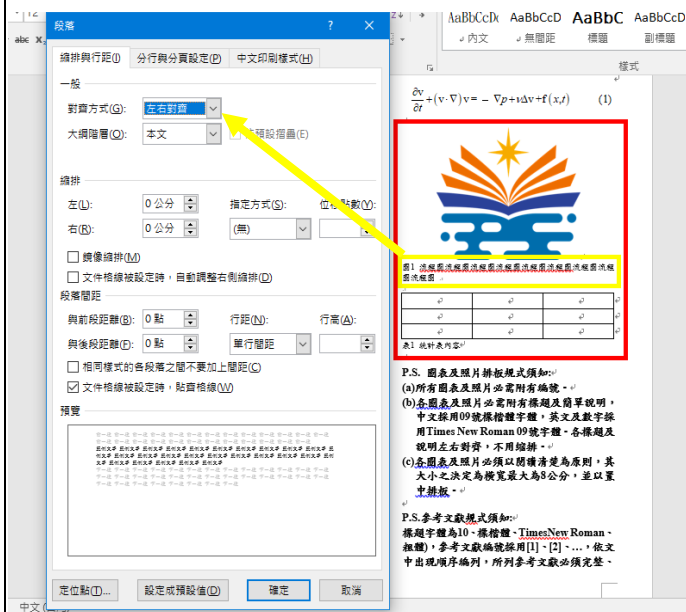
2.2 實驗流程  
 集會國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。  
 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

P.S. 排版規式須知：  
 (a)投稿文章用A4(210mm\*297mm)的紙張，每頁上下各空2.5公分，左2.5公分，右空1.5公分，除摘要使用單欄的編排格式，撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。  
 (b)內文中文採用12號標楷體字體，英文及數字採用12號Times New Roman字體，左右對齊。  
 (c)內文內容使用單行間距，前後段距離0行。  
 (d)中文每段第一行縮排1字元。  
 (e)英文每段第一行縮排5公分。  
 (f)標題與子標題須使用粗體，標題順序為1、

(h)第一層標題(如1.前言)使用粗體字型，字體為12號，第二層含以下之標題(如2.1 內文)使用粗體字型，字體為12號。  
 (i)標題及子標題靠左對齊，單行間距，前後段距離0行，但每節標題前加一行空行。  
 (j)所有公式及方程式均需用打字或書寫清楚，式號應標於圓括弧內並置於其後。

圖表及照片排版規式須知：  
 (a)所有圖表及照片必需附有編號。  
 (b)各圖表及照片必需附有標題及簡單說明，中文採用09號標楷體字體，英文及數字採用Times New Roman 09號字體，各標題及說明左右對齊，不用縮排。  
 (c)各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其大小之決定為橫寬最大為8公分，並以置中排版。

P.S. 參考文獻規式須知：  
 標題字體為10、標楷體、Times New Roman、粗體，參考文獻編號採用[1]、[2]、...，依文中出現順序編列，所列參考文獻必須完整、正確，格式如下例所示。



- 十四
- 參考文獻編號採用[1]、[2]、...等等以此類推，依文中出現順序編列，所列參考文獻必須完整、正確。
  - 中文參考文獻：『字型：標楷體、字體大小10、粗體、靠左對齊。』
  - 英文參考文獻：『字型：Time New Roman、字體大小10、粗體、靠左對齊。』

同時，也希望半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

P.S. 排版規式須知：<sup>41</sup>

(a) 投稿文章用A4(210mm\*297mm)的紙張，每頁上下各空2.5公分，左2.5公分，右空1.5公分，除摘要使用單欄的編排格式，撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。<sup>42</sup>

(b) 內文中文採用12號標楷體字體，英文及數字採用12號Times New Roman字體，左右對齊。<sup>43</sup>

(c) 內文內容使用單行間距，前後段距離0行。<sup>44</sup>

(d) 中文每段第一行縮排1字元。<sup>45</sup>

(e) 英文每段第一行縮排5公分。<sup>46</sup>

(f) 標題與子標題須使用粗體，標題順序為1, 2,...等等。<sup>47</sup>

(g) 子標題順序為1.1，本研討會規定至第二層止。<sup>48</sup>

(h) 第一層標題(如1.前言)使用粗體字型，字體為12號，第二層含以下之標題(如2.1 內文)使用粗體字型，字體為12號。<sup>49</sup>

P.S. 圖表及照片排版規式須知：<sup>41</sup>

(a) 所有圖表及照片必需附有編號。<sup>42</sup>

(b) 各圖表及照片必需附有標題及簡單說明，中文採用09號標楷體字體，英文及數字採用Times New Roman 09號字體。各標題及說明左右對齊，不用縮排。<sup>43</sup>

(c) 各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其大小之決定為橫寬最大為9公分，並以置中排版。<sup>44</sup>

P.S. 參考文獻規式須知：<sup>41</sup>

標題字體為10、標楷體、Times New Roman、粗體，參考文獻編號採用[1]、[2]、...，依文中出現順序編列，所列參考文獻必須完整、正確。格式如範例所示：<sup>42</sup>

[1] Wang, A. B. and Lin, C. D. (2011). Title of a Paper Published in a Journal. Journal of Power Engineering, 32(1), 101-123.

[2] 陳大同、王志明, 2009, 台灣風力發電之效能評估, 電力工程學報, 23(2), 212-225.

[3] 黃漢傑, 2010, 高微列車技術百科, 共和媒體出版, 74-76.